⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-35234

@Int\_Ci\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)2月23日

G 01 L 11/00

7507-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 圧力計測装置

> 创特 願 昭58-144242

昭58(1983)8月5日 ❷出

W 章 京都市右京区花園土堂町10番地 立石電機株式会社内 砂発 明 者 髙 元 明 平 正 夫 79発 者 野 京都市右京区花園土堂町10番地 立石電機株式会社内 明 幹 彦 伊発 者 志 村 京都市右京区花園土堂町10番地 立石電機株式会社内 伊発 明 日野田 征佑 京都市右京区花園土堂町10番地 立石電機株式会社内 ⑪出 願 人 立石電機株式会社 京都市右京区花園土堂町10番地 砂代 理 人 弁理士 岡本 宜喜 外1名

## 1. 発明の名称

圧力計測装置

### 2. 特許請求の範囲

(1) 圧力検出用の関口部を有するステム上に 該関口部を取り囲んで密閉されフォトルミネッセ ンス発光をする結晶板と、

前記結晶板の裏面を照射して前記結晶板を励起 させる光照射手段と、

前記光照射手段によって生じたルミネッセンス 光の発光状態の変化を検出する検出手段と、

圧力変化に基づく前記検出手段の検出値をあら かじめ記憶する記憶手段と、

前記検出手段による検出量を前記記憶手段の記 他値と比較して圧力を演算する演算手段と、を具 備することを特徴とする圧力計測装置。

(2) 前記結晶板は、前配光照射手段による光 照射額域をダイヤフラムとして構成したことを特 徴とする特許請求の範囲第1項記載の圧力計測装 置.

- (3) 前記検出手設は、ルジネッセンス光をそ の発光強度に対応した電気信号に変換する光電変 ・換器を有するものであり、ルミネッセンス光出力 の強度変化に基づいて圧力を計測するものである ことを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2 項記載の圧力計測装置。
- (4) 前記検出手段は、前記圧力に対応したフ オトルミネッセンス光の発光液長の変化領域のフ ィルタとそのフィルタ透過後の光が与えられる光 電変換器とを夫々複数有するものであり、圧力変 化に基づく波長変化によって圧力を計測するもの であることを特徴とする特許請求の範囲第1項又 は第2項記載の圧力計測装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

発明の分野

本発明はフォトルミネッセンスによる発光を利 用した圧力計測装置に関するものである。

従来技術とその問題点

従来の圧力計測装置としてはシリコンによって ダイヤフラムを形成すると共にその表面上に抵抗

特開昭60~ 35234(2)

分離が困難であり、叉分波器を要すると共に光ファイバが投受光用に二本必要であるため構造が複雑となり、叉針測器として使用した場合も函路が複雑になるという問題点があった。

#### 発明の目的

本発明は従来の圧力センサを用いた圧力計測装置の問題点を解消するものであって、フォトルミネッセンスによって圧力を計測する新規な圧力計測装置を提供するものである。

#### 発明の構成と効果

本発明は圧力検出用の関口部を有するステム上に拡関口部を取り関んで密閉されてまたいまない。 結晶板の表面を設計手段と、光照射手段と、光照射手段によったいままったが、近れの発光状での発光状では、圧力変化に基づくと、近りの検出値をあらかじめ記憶を記憶値と、後出手段による検出量を配憶手段の記憶値とと、を具備することを特徴とするものである。

#### 実施例の説明

第1図は本発明による圧力計測装置のセンサ部分を示す原理図である。本図においてステム1上にその関口部を取り囲んで密閉された物質2を設ける。この物質2は入射された光によってフォトルミネッセンス発光をする物質を用いるものとす

る。そして図示のようにその物質の上面にレーザ 光輝3よりレーザ光を照射すると、物質2はレー ザ光のエネルギーを吸収した後フォトルミネッセ ンス光を発する。このフォトルミネッセンス光の 波長は物質2のエネルギーギャップに依存する。 従って物質2に圧力が加わって格子亚を受けた場 合には、その格子間隔や結晶性が変化を起こし、 フォトルミネッセンス光の出力に変調を与えるこ ととなる。第1図に示すように物質2の上面を薄 くグイヤフラム状に形成するものとすれば、ステ ム1より加わった圧力によって図中に破線で示す ように物質2の表面の結晶格子が伸びる。このた めフォトルミネッセンスによる発光は長波長側に 移ることとなる。例えば励起光としてアルゴンレ ーザの514.5nm の波長によりGaAsの(100)の 単結晶を励起した場合には 840~850nm のフォト ルミネッセンス発光を生じる。従ってこのGaAs単 結晶に第1図に示す物質のように異方性エッチン グによりその中央部分にダイヤフラムを形成し、 ステム1からの圧力によって結晶が変化を受け易

**時開昭60-35234(3)** 

いような構造とすれば、圧力変化によって第2図(a)。(b)に示すようにフォトルミネッセンス光の波長は長くまた輝度は小さくなる。このダイヤフラムを例えば数十µに加工すれば約0.5 kg/cdまでの圧力測定が可能となり、更に高い圧力を測定する場合にはダイヤフラム部分を厚くすることによって検知することができる。

イオード等を用いることができるが、結晶板 6 と してGaP を使った場合にはアルゴンレーザの488. One や514.5nm の励起光でないとフォトルミネッ センスが生じない。結晶板6は単結晶のものであ ってもよく多結晶のものであってもよい。 この結 晶板 6 に測定すべき圧力を生ずる圧力発生源 7 が **第1図に示すように接続されており、その結晶板** 6 からのフォトルミネッセンス光が伝送路 8 を介 して検出回路9に与えられる。この計測装置が第 2 図似に示すように輝度の変化に基づいて圧力変 化を検出するものであれば、検出回路9はこのフ ォトルミネッセンス光を電気信号に変換する光電 変換器が用いられ、その出力は演算回路10に与 えられる。又この圧力計測装置が第2図(のに示す ように波長の変化に基づいて圧力を計測するもの であれば、検出回路9はその波長の変化領域内の 異なる透過特性を有する複数のフィルタと、夫々 のフィルタの出力嬉に設けられる光電変換器が用 いられる。演算回路10には更に、輝度変化に基 づく計測の場合は与えられた励起光に対応して生

する結晶板 6 のフォトルミネッセンス光の光量を記憶し、波長変化に基づく計測の場合は与えられた励起光に対応して出力を生じる光電変換器の組合せのデータを記憶する既知関数メモリ 1 1 が接続されており、その既知関数と比較することによって圧力を算出するものである。演算回路 1 0 の出力は圧力表示装置 1 2 に与えられて圧力発生源7の圧力が表示される。

第4図は伝送路として光ファイバを用いた場合の実施例である。光ファイバを用いた場合にはは、その伝送損失を考慮すれば励起光光子が適当して、本発光がイオード20の光光子が適当いている。発光がイオード20の光出力は光ファイバ21を介して分岐を伝送するもれる。光光がイオード20の光光の相違に一下20の光光がイオード20の光光の相違に一下20の大力を伝送するものであった。光ブァイバ23を介していまたられる光はそのまま光ファイバ23を介していまった。

関口部に設けられた半導体結晶体26のダイヤフ ラム中央部分に光ファイバ23の先端が対向する ようにフレーム27によって固定された構造を持 つものである。結晶版 2 6 としては、発光効率が 高く、叉異方性エッチングによりグイヤフラムを 容易に形成することができるので、AlGaAsやGaAs の結晶板等の直接遷移で発光する化合物半導体が 好ましい。さて光ファイバ23を通じて照射され た光によってフォトルミネッセンス発光が起こる と、そのフォトルミネッセンス光が同じく光ファ イバ23を通じて分岐器22に与えられる。分岐 器22はこれを分岐して光ファイバ28に与える。 光ファイバ28の先端には発光ダイオード20の 励起光をカットするフィルタ29及びフォトダイ オード30が接続される。このフィルタ29によ ってフォトルミネッセンス光のみをフォトダイオ - F 3 0 に与えて S N 比を改善するようにしてい る。フォトグイオード30の出力は検出回路31 に与えられる。検出回路31はフォトダイオード 30を駆動すると共に、その出力を増幅するもの

特開昭60-35234(4)

であって、その出力は演算目路32に与えられる。 演算回路32には前述の実施例と同様に既知関数 のメモリ33が接続されており、このデータと比 較することによって圧力を演算するものであって、 演算された圧力は圧力要示装置34によって要示 される。

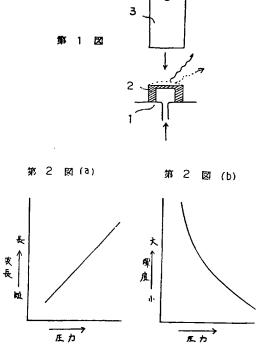
簡第4図の実施例では発光ダイオオード20によって連続的に結晶板26を駆動するようにしてよった。 るが、第6図向に示すように励起回路40によった もできる。そのとき第6図向に示すとしてするようにするようにするようにするようにするようにするようにするようにするときまりになるようとなるようとなるようとなるというとなった。 契はない。又励起光とフォトルミネッセンス光の対失にフォトダイオードの分光感度級知にあないといまればフィルタとなるといまれば、一つのフォトダイオードを検知回路にあるといいまないの理とを行うことが可能となる。

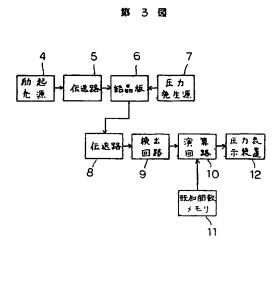
又、ここで説明した実施例では圧力の変化を波 長又は輝度の変化の関数として圧力を測定してい るが、これらのデータを組合せて圧力を測定する ようにすればより正確に圧力を測定することが可 供となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による圧力計湖装置のセンサ部分を示す原理図、第2 図(4)。 (4) は圧力に対する波長と輝度の変化を示すグラフ、第3 図は本発明による圧力計測装置の構成を示すブロック図、第4 図は光ファイバを用いた圧力計測装置の一実施例を示すブロック図、第5 図はそのセンサ部分の拡大図、第6 図は断続的に結晶板を励起する場合の励起信号とフォトルミネッセンス光の検出光を示すタイムチャートである。

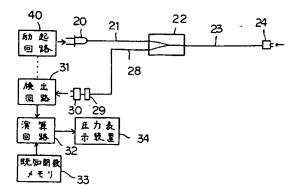
1,25……ステム 2……物質 4……励 記光源 5,8……伝送路 6,26……結 品板 7……圧力発生源 9,31……検出 回路 10,32……演算回路 11,33 ……展知関数メモリ 12,34……圧力表示 装置



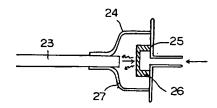


## 特問明60- 35234(6)

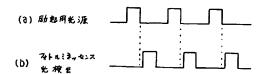
## 第 4 図



## 第 5 図



## 第6図



			ў. *•
		·	

## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

60035234

**PUBLICATION DATE** 

23-02-85

**APPLICATION DATE** 

05-08-83

APPLICATION NUMBER

58144242

APPLICANT: OMRON TATEISI ELECTRONICS CO:

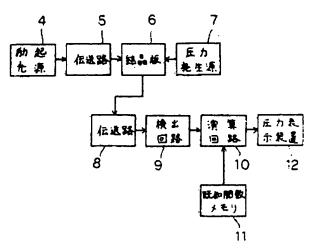
INVENTOR: HINOTA SEISUKE;

INT.CL.

: G01L 11/00

TITLE

: PRESSURE MEASURING DEVICE



ABSTRACT :

PURPOSE: To use photoluminescence light for transmission of data intactly, by projecting light on a crystal plate, detecting the change in light emitting state of the yielded photoluminescence light, and computing pressure based on the detected amount.

CONSTITUTION: Light from an exciting light source 4 is imparted to a crystal plate 6 through a transmission path 5. To the crystal plate 6, a pressure generating source 7, which generates pressure to be measured, is connected. Photoluminescence light from the crystal plate 6 is imparted to a detecting circuit 9 through a transmission path 8. The detecting circuit 9 converts the photoluminescence light into an electric signal. The output of the detecting circuit 9 is imparted to an operating circuit 10. The operating circuit 10 stores the amount of the photoluminescence light from the crystal plate 6, compares the value with the known function stored in a known function memory 11, and computes the pressure.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

		;
	, <b>*</b>	